

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 110472

ТЕНЗОРЕЗИСТОР (ВАРИАНТЫ)

Патентообладатель(ли): *Общество с ограниченной ответственностью "Эс эм Эс - Тензо" (RU)*

Автор(ы): *Каминский Владимир Васильевич (RU), Соловьёв Сергей Михайлович (RU), Голубков Александр Васильевич (RU), Володин Николай Михайлович (RU)*

Заявка № 2011118769

Приоритет полезной модели 10 мая 2011 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20 ноября 2011 г.

Срок действия патента истекает 10 мая 2021 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simonov'.

Б.П. Симонов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОПИСАНИЯ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2011118769/28, 10.05.2011

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
10.05.2011

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 10.05.2011

(45) Опубликовано: 20.11.2011 Бюл. № 32

Адрес для переписки:

194021, Санкт-Петербург, ул.
Политехническая, 26, Патентно-
лицензионная служба ФТИ им. А.Ф. Иоффе
РАН

(72) Автор(ы):

Каминский Владимир Васильевич (RU),
Соловьёв Сергей Михайлович (RU),
Голубков Александр Васильевич (RU),
Володин Николай Михайлович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Общество с ограниченной
ответственностью "Эс эм Эс - Тензо" (RU)

(54) ТЕНЗОРЕЗИСТОР (ВАРИАНТЫ)**(57) Формула полезной модели**

1. Тензорезистор для измерения деформаций и давления, включающий диэлектрическую подложку с нанесенным тензочувствительным слоем в виде поликристаллической пленки, содержащей сульфид самария, и металлическими контактными площадками, расположенными на одной поверхности пленки, с припаянными к ним токовыводами, отличающийся тем, что тензочувствительный слой выполнен с отверстиями, соединяющими контактные площадки, и имеет состав $Sm_{1-x}Ln_xS$, где Ln - один из элементов: La, Ce, Pr, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, Y, при $0 < x < 0,3$.

2. Тензорезистор для измерения деформаций и давления, включающий диэлектрическую подложку с нанесенным тензочувствительным слоем в виде поликристаллической пленки, содержащей сульфид самария, и металлическими контактными площадками, расположенными на одной поверхности пленки, с припаянными к ним токовыводами, отличающийся тем, что тензочувствительный слой выполнен с отверстиями, соединяющими контактные площадки, и имеет состав $Sm_{1+z}S$, где $0 < z \leq 0,17$.

RU 110472 U1

RU 110472 U1



